

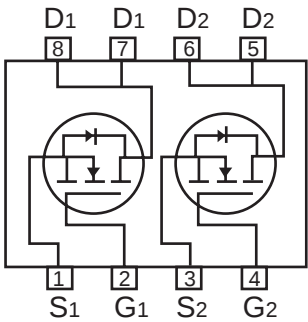
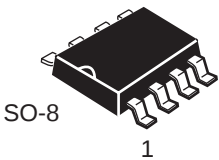
CEM8206

Feb. 2003

Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

FEATURES

- 20V , 6A , $R_{DS(ON)}=20m\Omega$ @ $V_{GS}=4.5V$.
 $R_{DS(ON)}=30m\Omega$ @ $V_{GS}=2.5V$.
- Super high dense cell design for extremely low $R_{DS(ON)}$.
- High power and current handing capability.
- Surface Mount Package.



5

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage	VDS	20	V
Gate-Source Voltage	VGS	±12	V
Drain Current-Continuous ^a -Pulsed	ID	±6	A
	IDM	±24	A
Drain-Source Diode Forward Current ^a	IS	6	A
Maximum Power Dissipation ^a	PD	2	W
Operating Junction and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to 150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Thermal Resistance, Junction-to-Ambient ^a	RθJA	62.5	°C/W
--	------	------	------

CEM8206

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C unless otherwise noted)

5

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ ^c	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} = 0V, I _D = 250μA	20			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = 20V, V _{GS} = 0V			1	μA
Gate-Body Leakage	I _{GSS}	V _{GS} = ±12V, V _{DS} = 0V			±100	nA
ON CHARACTERISTICS ^b						
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA	0.5		1.5	V
Drain-Source On-State Resistance	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 4.5V, I _D = 6.0A		17	20	mΩ
		V _{GS} = 2.5V, I _D = 5.2A		23	30	mΩ
On-State Drain Current	I _{D(ON)}	V _{DS} = 5V, V _{GS} = 4.5V	10			A
Forward Transconductance	g _{FS}	V _{DS} = 10V, I _D = 6.0A	7	16		S
DYNAMIC CHARACTERISTICS ^c						
Input Capacitance	C _{ISS}	V _{DS} = 8V, V _{GS} = 0V f = 1.0MHz		950		pF
Output Capacitance	C _{OSS}			450		pF
Reverse Transfer Capacitance	C _{RSS}			135		pF
SWITCHING CHARACTERISTICS ^c						
Turn-On Delay Time	t _{D(ON)}	V _{DD} = 10V, I _D = 1A, V _{GS} = 4.5V, R _{GEN} = 6Ω		20	40	ns
Rise Time	t _r			20	40	ns
Turn-Off Delay Time	t _{D(OFF)}			72	130	ns
Fall Time	t _f			20	40	ns
Total Gate Charge	Q _g	V _{DS} = 10V, I _D = 6A, V _{GS} = 4.5V		15	20	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}			3.4		nC
Gate-Drain Charge	Q _{gd}			1.2		nC

CEM8206

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ ^c	Max	Unit
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS^b						
Diode Forward Voltage	V _{SD}	V _{GS} = 0V, I _S =1.7A		0.75	1.2	V

5

Notes

- a.Surface Mounted on FR4 Board, t ≤10sec.
- b.Pulse Test:Pulse Width ≤300 μs, Duty Cycle ≤2%.
- c.Guaranteed by design, not subject to production testing.

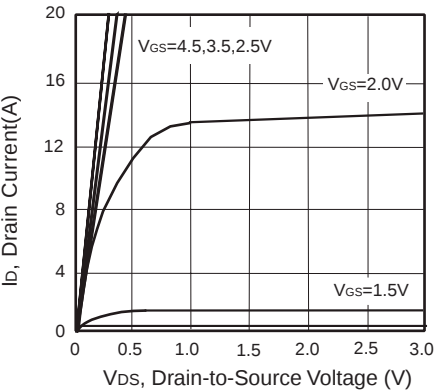


Figure 1. Output Characteristics

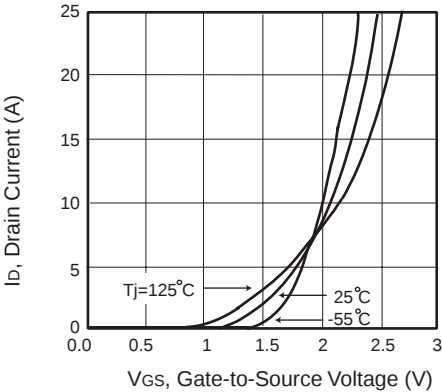


Figure 2. Transfer Characteristics

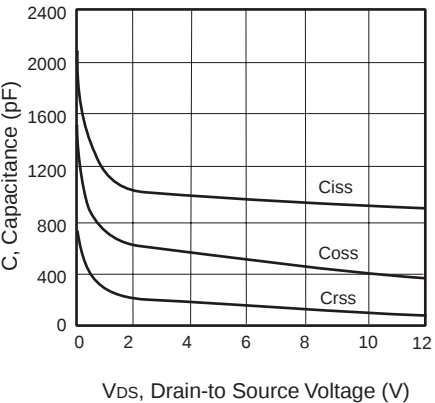


Figure 3. Capacitance

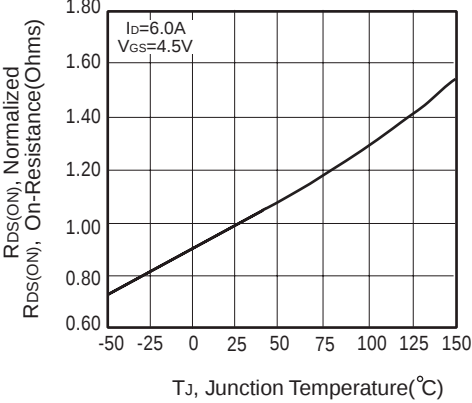


Figure 4. On-Resistance Variation with Temperature

CEM8206

5

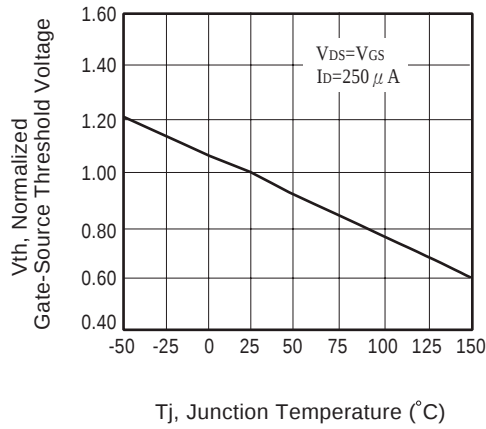


Figure 5. Gate Threshold Variation with Temperature

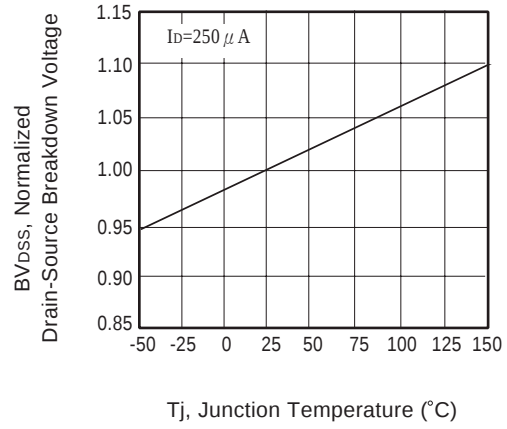


Figure 6. Breakdown Voltage Variation with Temperature

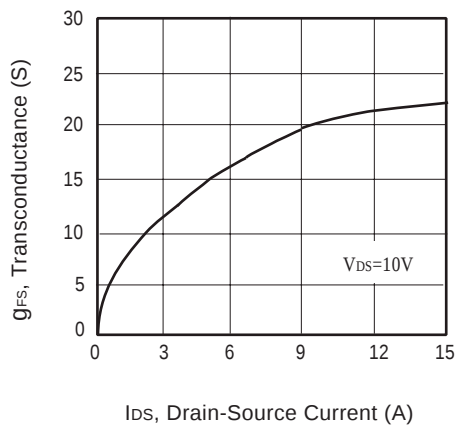


Figure 7. Transconductance Variation with Drain Current

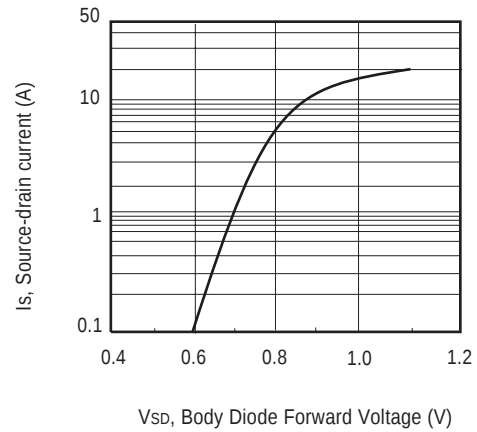


Figure 8. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current

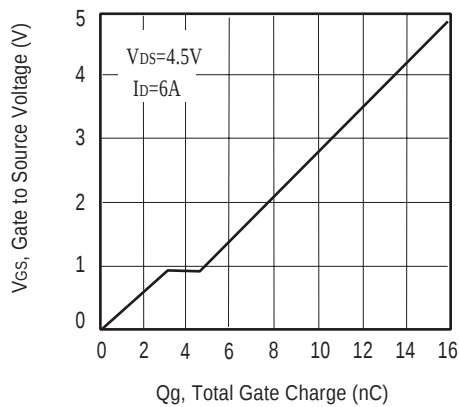


Figure 9. Gate Charge

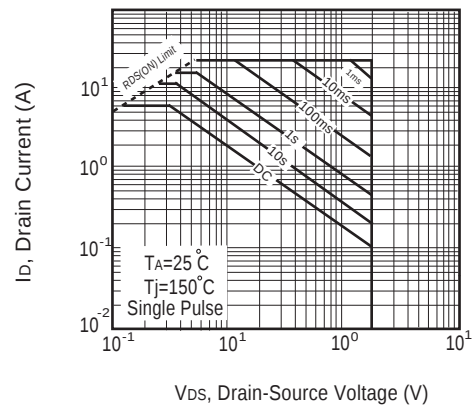


Figure 10. Maximum Safe Operating Area

CEM8206

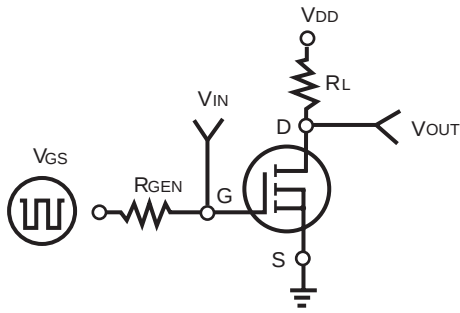


Figure 11. Switching Test Circuit

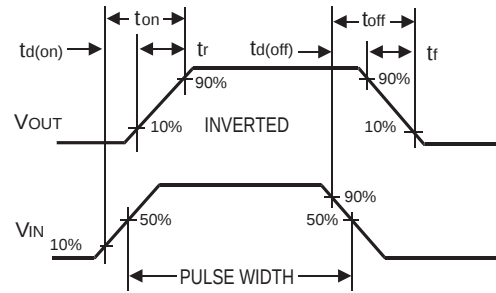


Figure 12. Switching Waveforms

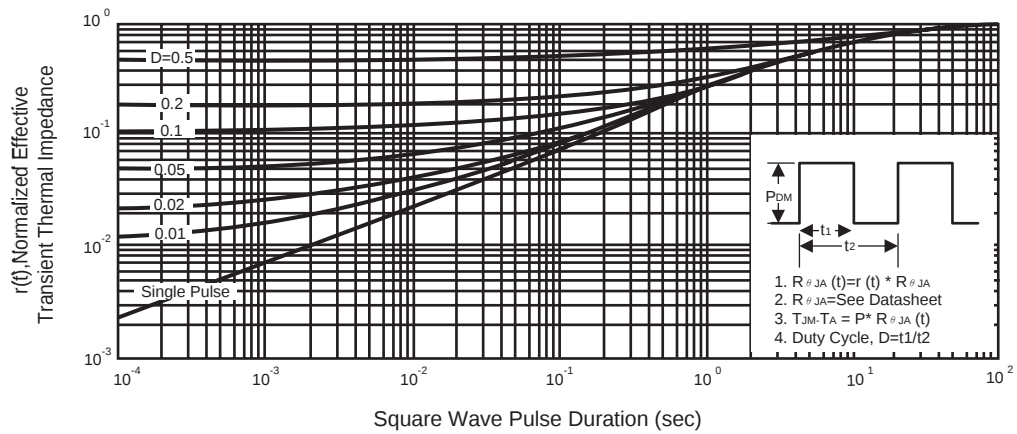


Figure 13. Normalized Thermal Transient Impedance Curve



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331